



MX0400309

4SB3 **CARACTERIZACIÓN DE PELICULAS DE SiN/Si USANDO DISPERSIÓN DE IONES.**- G. Murillo, R. Policroniades, Acelerador Tandem, ININ, Depto. del Acelerador, Apdo. Postal 18-1027, 11801 México D. F. E. Andrade. E. P. Zavala, IFUNAM, Apdo. Postal 20-364, 01000 México D. F. En este trabajo se presenta el análisis de películas delgadas de SiN, sobre un sustrato de Si, usando dispersión de iones de D, ^3He , $^7\text{Li}^{2+}$ y $^{12}\text{C}^{3+}$. Se conjugan los resultados del análisis con estos iones para obtener la estequiometría de las películas, así como sus espesores. Estas películas fueron preparadas exponiendo un sustrato de silicio tipo-n a vapores de gas NH_3/SiH_4 asistidos por plasma (PECVD).